









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD042P03L3GATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 70A TO252-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPD042P03L3GATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD042P03L3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 70A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 270µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.2 mOhm @ 70A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	12400pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	175nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	70A (Tc)

IPD042P03L3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD042P03L3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD042P03L3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD042P03L3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD040N03LGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 90A TO252-3</p>	 <p>IPD046N08N5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 80V 90A TO252-3</p>	 <p>IPD042P03L3G Doingte IPD042P03L3G Doingte</p>	 <p>IPD048N06L3G INFINEON IPD048N06L3G INFINEON</p>
 <p>IPD042P03L3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 30V 70A TO252-3</p>	 <p>IPD040N03LG INFINEON IPD040N03LG INFINEON</p>	 <p>IPD040N03LGBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 90A TO252-3</p>	 <p>IPD042P03L3 G INFINEON IPD042P03L3 G INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD042P03L3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD042P03L3GATMA1 Datenblatt	IPD042P03L3GATMA1-Datenblätter	IPD042P03L3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD042P03L3GATMA1
IPD042P03L3GATMA1 Electronic	IPD042P03L3GATMA1-Komponenten	IPD042P03L3GATMA1-Verteiler	IPD042P03L3GATMA1-Bild	IPD042P03L3GATMA1-Teil
IPD042P03L3GATMA1 Preis	IPD042P03L3GATMA1 Hersteller	IPD042P03L3GATMA1 Bild	IPD042P03L3GATMA1 Aktie	IPD042P03L3GATMA1 Inventar
IPD042P03L3GATMA1 Neu	IPD042P03L3GATMA1 Original	IPD042P03L3GATMA1 garantiert	IPD042P03L3GATMA1 RFQ	IPD042P03L3GATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited